

Generali

n	Numero elettroni liberi per unità di volume
p	Numero di lacune...
$n_i(T)$	Coefficiente di generazione coppie elettroni/lacune
T	Temperatura
K	Costante di Boltzman
N_A	Numero di atomi accettori per unità di volume
N_D	Numero di atomi donatori per unità di volume
ρ	Densità di carica, carica per unità di volume
\bar{J}	Densità di corrente, corrente per unità di superficie (?)
σ	Conducibilità, inverso della resistenza
\bar{E}	Campo elettrico
q	Carica elettrone (valore positivo)
μ_n	Mobilità elettronica carica negativa in un materiale
D_n	Coefficiente di diffusione cariche negative
ϵ_s	Costante dielettrica silicio
φ	Potenziale

Giunzione P-N

w_n	Larghezza regione svuotata lato n
w_p	Larghezza ... p
ψ_b	Potenziale di barriera nella zona neutra (?)
ψ_{cp}	Potenziale di contatto metallo-semiconduttore p
ψ_{cn}	Potenziale di contatto ... n
I_S	Corrente di saturazione inversa del diodo (parametro dato)
V_γ	Tensione di soglia del diodo
τ	Tempo di vita medio dei portatori
Q	Carica

Transistor

α_F	Efficienza di emettitore (polarizzazione diretta)
β_F	Efficienza collettore (?) Guadagno base-collettore
V_{CESat}	Tensione di saturazione inversa (dato)
A_V	Guadagno
N_M	Noise Margin (margine rumore)
N_{ML}	Noise Margin per valore basso
N_{MH}	Noise Margin per valore alto
V_{iLMax}	Massima tensione in entrata identificata come valore basso
V_{OHMin}	Minima tensione in uscita con valore alto

FET

ϵ_{OX}	Costante dielettrica strato di ossido
φ_F	Potenziale di Fermi (condizione di debole inversione)
V_T	Tensione di soglia (Threshold)
L	Lunghezza canale
W	Larghezza canale (width)
β_n	Costante determinata da forma e proprietà fisiche del MOS
t_p	Tempo di propagazione dell'invertitore
$\langle P_{CC} \rangle$	Potenza dissipata (cortocircuito)